Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0214U006886

Державний реєстраційний номер: 0108U004836

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-03-2014

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 5

Назва етапу: Розроблення відповідних електронних і програмних продуктів для обробки сигналів від матриці сенсорних елементів діодних структур чутливих до рентгенівського і гама випромінювання. Створення експериментального комплексного приладу для детектування ядерного випромінювання і експрес-аналізу. Пошуки шляхів впровадження і комерцілізації результатів розробки.

Початок етапу: 01.2012

Закінчення етапу: 12.2012

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Президія Національної академії наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380 44 525-40-20 , 380 44 525-83-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 104

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення і створення матриць сенсорних діодних структур та приладу для детектування ядерного випромінювання

Назва роботи англійською:

Development and creation of sensor diode structure arrays and device for nuclear radiation detection

Реферат українською:

Розробленя відповідних електронних і програмних продуктів для обробки сигналів від матриці сенсорних елементів діодних структур чутливих до рентгенівського і гама випромінювання.

Реферат англійською:

Designed relevant electronic and software for processing signals from the sensor matrix element diode structures are sensitive to X-ray and gamma radiation.

Індекс УДК: 621.384.6; 621.384.647, 621.386.82; 535.21

Коди тематичних рубрик: 47.29.39

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Власенко Олександр Іванович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Електронні та програмні продукти для обробки сигналів від матриці сенсорних елементів діодних структур чутливих до рентгенівського і гама випромінювання.

Назва НТП англійською: Electronic and software for processing signals from the sensor matrix element diode structures are sensitive to X-ray and gamma radiation.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: К 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблення відповідних електронних і програмних продуктів для обробки сигналів від матриці сенсорних елементів діодних структур чутливих до рентгенівського і гама випромінювання.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: -

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: НАНУ

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

V.A. Gnatyuk, O.I. Vlasenko, M.O. Semenenko, S.N. Levytskyi, T. Aoki, A. Koike, Features of the electrical characteristics of In/CdTe/Au diode structures developed for high energy radiation // Proceedings of The 11th International Conference on Global Research and Education in Engineers and Better Life: Inter-Academia 2012. - P. 27-34. V.A. Gnatyuk, O.I. Vlasenko, S.N. Levytskyi, E. Dieguez, J. Crocco, H. Bensalah, M. Fiederle, A. Fauler, T. Aoki, Surface processing of CdZnTe crystals, Hard X-Ray, Gamma-Ray, and Neutron Detector Physics XIV. Proceedings of SPIE, Vol. 8507 (Oct. 2012) 85071S-1-5.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Перелік осіб-виконавців

Велещук В.П.

Власенко З.К.

Гнатюк В. А.

Левицький С.М.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

